

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 (29 ноября 14⁰⁰ – 15³⁰)

У6 Акмаев М.А.
студ., МГУ, Москва

Диполярная электронно-дырочная жидкость в SiGe/Si гетеросистеме

У7 Галимов А.И.
студ., СПбПУ, С.-Петербург

Оптические свойства наноструктур GaN/AlGaIn в терагерцовом диапазоне частот

У8 Фадеев М.А.
асп., Институт физики
микроструктур,
Нижний Новгород

Двухчастотная генерация стимулированного излучения на межзонных и примесно-зонных переходах в гетероструктурах с квантовыми ямами HgCdTe/HgTe

У9 Былинкин А.Н.
студ., МФТИ, Москва

Резонансное туннелирование с участием фотонов и поверхностных плазмонов в гетероструктурах на основе графена

У10 Казанцев Д.М.
асп., ИФП СО РАН,
Новосибирск

Термодинамическое и кинетическое разупорядочение: моделирование Монте-Карло и эксперимент на GaAs

У11 Бавтович И.М.
студ., СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
С.-Петербург

Исследование гетероструктур на основе арсенидов оптическими методами

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3 (29 ноября 15⁴⁵ – 17¹⁵)

У12 Свинцов Д.А.
с.н.с., МФТИ, Москва

Туннельные фотодетекторы на основе Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур

У13 Рахлин М.В.
асп., ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН,
С.-Петербург

Излучательные характеристики источников одиночных фотонов на основе квантовых точек CdTe/ZnTe

У14 Ченцов С.И.
студ., НИЯУ «МИФИ», Москва

Исследование одиночных дефектов в квантовых ямах ZnSe/ZnMgSSe методом микрофотолюминесценции

У15 Еналдиев В.В.
м.н.с., ИРЭ РАН, Москва

Резонансное усиление генерации второй гармоники краевыми состояниями в монослоях дихалькогенидов переходных металлов

У16 Юрков К.К.
студ., СПбПУ, С.-Петербург

Поглощение излучения свободными электронами в эпитаксиальных слоях GaN в электрическом поле